

## Popis a použití

Tento druh [tranzistorů](#) je nejrozšířenější z tranzistorů řízených elektrickým [polem](#). Jedná se o typ tranzistoru, u kterého je vodivost kanálu mezi elektrodami S a D řízena elektrickým polem vytvářeným ve struktuře kov - oxid - [polovodič elektrickým napětím](#) přiloženým mezi řídicí elektrodou G a elektrodou S.

[MOSFET](#) je zkratkové slovo, v němž jednotlivá písmena znamenají:

1. M (*metal*) - řídicí elektroda G je tvořena kovem (většinou se jedná o hliník);
2. O (*oxide*) - řídicí elektroda G je od zbytku tranzistoru izolovaná tenkou vrstvou oxidu křemičitého (tj. nevodivým křemenem);
3. S (*semiconductor*) - oxid křemičitý je nanesen na polovodičové destičce;
4. [FET](#) (*field effect transistor*) - tranzistor je řízený elektrickým polem.

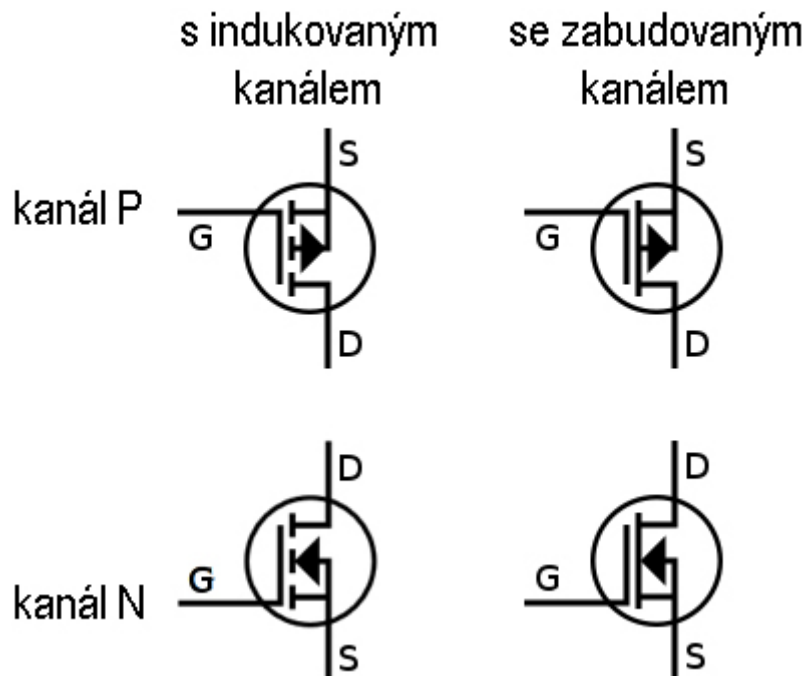
Schématické značky základních typů tranzistoru MOSFET jsou zobrazeny na obr. 229.

U tranzistoru typu N míří šipka dovnitř (k elektrodě G), u tranzistoru P opačně. Šipky jsou tedy **OPAČNĚ** než u [bipolárních tranzistorů](#)

Existují další značky pro další typy tranzistorů MOSFET.

Obecně by značka měla mít čtyři vývody (elektrody G, S, D a B), ale ve většině aplikací se musí přiložit na elektrody určité napětí, a proto se elektrody S a B většinou spojují. Proto jsou na schématu na obr. 229 zobrazeny pouze tři elektrody.

Při srovnání s bipolárním tranzistorem odpovídá elektroda G [bázi](#) tranzistoru, elektroda S [emitoru](#) a elektroda D [kolektoru](#).



Obr. 229

Tranzistory MOSFET mohou být dvou základních typů:

1. PMOS - základní deska je vyrobena z křemíkového [polovodiče typu N](#), elektrody jsou připojeny k obohacenému křemíkovému [polovodiči typu P](#);
2. NMOS - základní deska je vyrobena z křemíkového polovodiče typu P, elektrody jsou

připojeny k obohacenému křemíkovému polovodiči typu N.

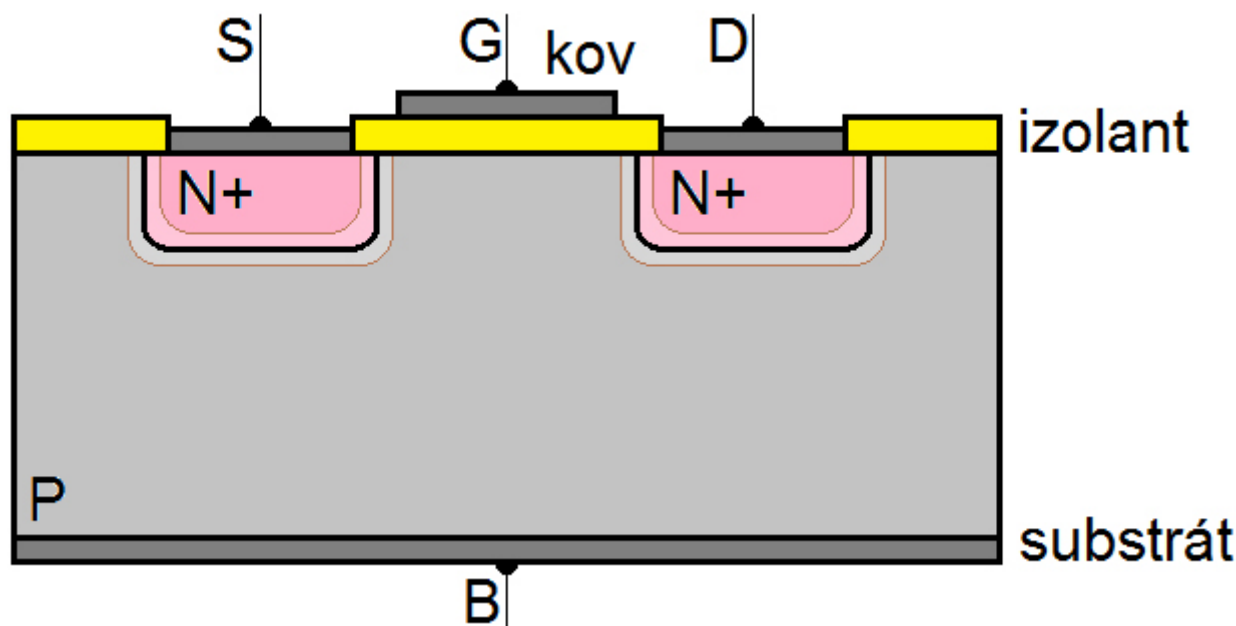
CMOS není označení tranzistorů, ale označení logických obvodů vytvářených kombinací tranzistorů PMOS a NMOS. V těchto obvodech je otevřený vždy jeden tranzistor, druhým z nich [elektrický proud](#) neprotéká.

Struktura tranzistoru NMOS je zobrazena na obr. 230. Základem je různě obohacený křemík tak, abychom měli k dispozici polovodič typu P a silně dotovaný polovodič typu N. V tomto typ polovodiče tedy jednoznačně převažuje [elektronová vodivost](#); počet [děr](#) je zde silně oslaben.

V polovodiči N běžně převažuje elektronová vodivost nad [děrovou vodivostí](#), ale v tomto případě je počet děr prostě výrazně menší, než u „běžného“ polovodiče N. Proto díry elektrický proud v polovodiči N+ nevedou!

Elektroda G (gate) je od polovodiče typu P oddělena [izolantem](#) tvořeným oxidem křemičitým. Elektrody S (source) a D (drain) jsou vodivě spojeny s polovodičem typu N. Elektroda B (bulk) připojená k substrátu je ve většině případů použití tranzistoru MOSFET spojena s elektrodou S.

Oba typy polovodiče vytvářejí [přechod PN](#), v jehož okolí je oblast bez volných nosičů náboje (tato oblast je na obr. 230 naznačena světlou barvou v okolí hranice polovodiče typu N). Tato oblast má tedy velký [elektrický odpor](#).



Obr. 230

Tyto tranzistory jsou základním aktivním prvkem většiny současných elektronických přístrojů; v současné době se používají výrazně více, než klasické bipolární tranzistory. Používají se jak v signálových analogových obvodech a digitálních obvodech (digitální technice), tak i ve výkonové elektronice. V současné době se vyrábějí MOSFETy i na bázi SiC (silikon-karbid) a GaAs (galium arsenid), čímž se rozšířilo použití těchto tranzistorů i do oblastí vyšších napětí (několik set až tisíc voltů).

Tranzistory MOSFET (oba z výše popsaných typů) se dále dělí podle typu vodivého kanálu:

1. s [indukovaným kanálem](#);
2. se [zabudovaným kanálem](#).

Vodivost jednotlivých typů tranzistoru v závislosti typu kanálu a na přiloženém napětí  $U_{GS}$  je popsána v tab. 1.

Typ kanálu	$U_{GS} > 0$	$U_{GS} = 0$	$U_{GS} < 0$
------------	--------------	--------------	--------------

indukovaný N	vede	nevede	nevede
zabudovaný N	vede	vede	nevede
indukovaný P	nevede	nevede	vede
zabudovaný P	nevede	vede	vede

*tab. 1*

---

© **Encyklopedie Fyziky** (<http://fyzika.jreichl.com>); **Jaroslav Reichl, Martin Všeticka**

Licence <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> zakazuje úpravy a komerční distribuci.